

Тематический указатель статей, опубликованных в 1998 году

Фундаментальные исследования

Алексеев А.М., Попков А.Ф. Спектр спинволновых возбуждений доменной границы в двуосном ферромагнетике в длинноволновом пределе. № 6 стр. 16.

Алексеев А.М., Попов А.И., Попков А.Ф. Спиновые возбуждения доменных границ кубических магнетиков с наведенной анизотропией и сильноанизотропных феррогранатов. № 1 стр. 13.

Горбачев А.А., Подгорнов Е.Г. Нелокальная модель процесса ударной ионизации в кремнии. № 2 стр. 16.

Заграй Н.П. Исследование нелинейного акустического резонатора на пьезополупроводнике InSb при импульсном возбуждении. № 1 стр. 3.

Карасев В.А., Лучинин В.В. Проблемы создания искусственных бионических микро- и наносистем. I. Молекулярная архитектура элементной базы. № 5 стр. 53.

Карасев В.А., Лучинин В.В. Проблемы создания искусственных бионических микро- и наносистем. II. Физические основы надмолекулярных систем. № 6 стр. 5.

Мордвинцев В.М. Проводимость электроформованных структур металл - изолятор - металл с самоорганизацией нанометрового изолирующего зазора в углеродистой проводящей среде. № 6 стр. 23.

Холомина Т.А. Физический механизм нестационарной спектроскопии глубоких уровней и генерации низкочастотного шума в барьерных слоях. № 2 стр. 22.

Материалы и технологические процессы электронной техники

Аврутин В.С., Зайцев А.А., Карцев А.Т., Тихомиров С.А. Пашаев Э.М., Изучение структуры многослойных изоморфных гетерокомпозиций на основе $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x/\text{Si}$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. № 4 стр. 11.

Барабан А.П., Кузнецова А.А., Малявка Л.В., Шишлова А.В. Распределение зарядов в окисном слое структур Si-SiO₂, подвергнутых имплантации и отжигу. № 4 стр. 17.

Будагян Б.Г., Шерченков А.А., Сазонов А.Ю., Страхилев Д.А. Структурные особенности пленок a-Si:H приборного качества, полученных в низкочастотной плазме тлеющего разряда. № 3 стр. 9.

Волков С.И., Григорашивили Ю.Е., Сотников И.Л., Мингазин В.Т. Пленки высокотемпературного сверхпроводника с критической температурой выше 100 К. № 3 стр. 14.

Громов Д.Г., Мочалов А.И., Пугачевич В.П. Свойства контактной системы TiN-Co/Si₂, сформированной твердофазным синтезом из пленки Ti-Co-N. № 1 стр. 24.

Китиченко Т.С., Колесникова Т.Г., Коровин А.П., Кощавцев Н.Ф., Федоров Ю.В., Чапнин В.А. Глубокие центры захвата в высокоомном арсениде галлия, используемом для создания преобразователей изображения ИК-диапазона. № 3 стр. 19.

Морозова Н.К., Каретников И.А., Давыдов А.А., Жаворонков Н.В. Сцинтилляционные материалы на основе композитов ZnSe-SnTe-ZnO. № 1 стр. 19.

Петрова В.З., Гребенькова В.И., Часовникова Е.В. Исследование процесса формирования структуры стеклокристаллического композиционного материала для конструкционных изделий электронной техники. № 4 стр. 3.

Попов А.И., Лигачев В.А., Стукач С.Н., Васильева Н.Д. Полиморфизм углерода и его влияние на электрические и оптические свойства пленок С:Н. № 3 стр. 5.

Руденко А.А., Чередниченко Д.И. Устойчивость границы фазового перехода при электронно-лучевой рекристаллизации тонкого слоя поликремния на окисленной подложке. № 1 стр. 31.

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы

Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Щелева И.М. Источники малых токов в микросхемах на арсениде галлия. № 5 стр. 91.

Алгазинов Э.К., Аверина Л.И., Бобрешов А.М., Дыбой А.В. Влияние электрофизических и геометрических параметров GaAs полевых транзисторов с затвором Шоттки на нелинейные характеристики входных малошумящих усилителей. № 6 стр. 63.

Амеличев В.В., Чаплыгин Ю.А. Интегральный сенсор магнитного поля комбинированного типа. № 2 стр. 41.

Барабан А.П., Дрозд В.Е., Зулуев З.Н., Никифорова И.О., Сазонов С.Г. Проводимость и зарядовые свойства структур металл - слоистый диэлектрик - полупроводник. № 2 стр. 37.

Блинов Ю.Ф., Серба П.В. Баллистическое перемешивание при ионно-стимулированном осаждении пленок. № 5 стр. 86.

Галушков А.И., Голишиников А.А., Путря М.Г., Рыбачек Е.Н., Чаплыгин Ю.А. Исследование влияния плазменной обработки в скрещенных электромагнитных полях на электрофизические параметры элементов СБИС. № 1 стр. 43.

Гергель В.А., Тимофеев М.В., Зеленый А.П. Влияние перезарядки мелких поверхностных состояний на крутизну МДП-транзисторов. № 6 стр. 43.

Горбатый И.Н. Высокочастотный инжекционный пробой $p-i-n$ -диода. № 6 стр. 55.

Горлов М.И., Зенин В.В., Колычев А.И. Исследование влияния состава алюминиевой металлизации на качество микросварных соединений алюминий - алюминий. № 6 стр. 67.

Евстигнеев С.В., Садофьев Ю.Г., Шипицин Д.С., Шмелев С.С. Неплавные алюминиевые омические контакты к структуре p НЕМТ-транзистора. № 4 стр. 21.

Королев М.А., Шумский И.А. "Интеллектуальные" силовые ИС на основе технологии кремний - на - изоляторе. № 2 стр. 45.

Мещеряков С.А., Прокопьев А.И. Влияние барьерных свойств низкоомной подложки на модуляцию сопротивления базы диода Шоттки. № 2 стр. 27.

Неволин В.Н., Фоминский В.Ю., Алехин А.П. Газофазные низкотемпературные УФ-индуцированные процессы для кремниевой технологии. I. Очистка подложки. № 5 стр. 69.

Неволин В.Н., Фоминский В.Ю., Алехин А.П. Газофазные низкотемпературные УФ-индуцированные процессы для кремниевой технологии. II. Осаждение и отжиг тонких слоев. № 6 стр. 33.

Новиков С.Г., Бакланов С.Б., Гурин Н.Т. Исследование полупроводниковых самосканирующих устройств с шунтирующим методом управления. № 4 стр. 31.

Сауров А.Н. Графическая модель метода самоформирования интегральных структур. № 1 стр. 61.

Сивяков Б.К., Сивяков Д.Б. Нелинейная модель ПТШ для анализа искажений сигналов. № 1 стр. 56.

Столяров А.А. Исследование влияния пассивирующих слоев на нестабильность зарядов МДП-структур при туннельной инжекции. № 2 стр. 30.

Трусова А.Ю., Рожков В.А., Бережной И.Г. Электрофизические свойства кремниевых МДП-структур с оксидом иттербия в качестве диэлектрика. № 4 стр. 25.

Хайновский В.И., Уздовский В.В., Гордо Н.М. Процессы переноса заряда в спектрально-анализируемых фоточувствительных двухканальных объемных приборах с зарядовой связью. № 6 стр. 49.

Хохлов А.И., Чуканов С.В., Шульга В.Г. Методы и оборудование для монтажа пластин кремния большого диаметра на технологическом этапе химико-механического полирования. № 4 стр. 37.

Шевяков В.И. Особенности образования барьера в реальных контактах металл - ковалентный полупроводник. № 1 стр. 49.

Схемотехника и проектирование

Адамов Д.Ю., Старосельский В.И. Проектирование счетных устройств на полевых транзисторах с затвором Шотки. № 1 стр. 79.

Алгазинов Э.К., Бобрешов А.М., Иркутский О.А. Малошумящий усилитель на полевом транзисторе при различных электрических режимах работы. № 4 стр. 50.

Алексян И.Т., Черняев И.В. Обобщенная модель надежности изделий. № 1 стр. 85.

Алексян И.Т., Черняев Н.В. Управление надежностью интегральных микросхем на основе информационной избыточности. № 4 стр. 62.

Бакланов С.Б., Гурин Н.Т., Кузнецов В.В., Новиков С.Г. Трехтранзисторные схемы замещения в моделировании МДП-симисторов и симисторных оптопар. № 1 стр. 71.

Баринов В.В., Шельхманов Д.Е. Распознавание фрагментов библиотечных элементов СБИС для задач визуального контроля и верификации топологии. № 4 стр. 55.

Полевиков В.В., Шагурин И.И., Шиллер В.А. БМК "Рапира": особенности конструкции и характеристики библиотеки функциональных элементов. № 2 стр. 57.

Сычев А.Н. Аналитическая модель связанных микрополосковой и копланарно-желобковой линий для САПР. № 2 стр. 66.

Турулин И.И. Проектирование цифровых рекурсивных фильтров с конечной импульсной характеристикой на интеграторах. № 6 стр. 73.

Швецов-Шиловский И.Н. Регуляризация задачи идентификации параметров для схемотехнических моделей активных элементов ИС. № 4 стр. 43.

Микропроцессорная техника

Каляев А.В., Галуев Г.А. Математические модели нейронов и их компьютерная реализация. № 2 стр. 77.

Каляев А.В., Каляев И.А., Левин И.И., Пономарев И.М. Базовый модуль для построения реконфигурируемых под задачу вычислительных систем. № 4 стр. 67.

Умняшкин С.В., Кочетков М.Е. Анализ эффективности использования дискретных ортогональных преобразований для цифрового кодирования коррелированных данных. № 6 стр. 79.

Методы и техника измерений

Бормонтов Е.Н., Головин С.В. Автоматизированная установка для контроля и анализа электрофизических характеристик МДП-структур. № 4 стр. 95.

Гагарина Л.Г. Автоматизация технологических испытаний как средство повышения качества фотоэлектронных приборов. № 5 стр. 97.

Громов Д.В. Исследование переходных ионизационных эффектов в GaAs структурах лазерными методами. № 2 стр. 85.

Дмитриев А.К., Луговой А.А., Пугач Ю.П., Титов Е.А. Телескопический резонатор с низким уровнем влияния угловой разъюстировки зеркал на мощность излучения лазера. № 6 стр. 85.

Зайцев А.К., Клюдзин В.В. Методы уменьшения уровня боковых лепестков аппаратной функции акустооптического спектрометра. № 4 стр. 75.

Ильин И.Ю., Конакова Р.В., Ренгевич А.Е. Соловьев Е.А. Измерительный модуль и программное обеспечение стенда контроля параметров полевых транзисторов. № 4 стр. 101.

Кубарев Ю.В., Черник В.Н. Исследование характеристик магнитоплазменодинамического генератора кислородной плазмы для технологических приложений. № 4 стр. 89.

Новиков Ю.А., Раков А.В., Филиппов М.Н. РЭМ-изображение субмикронных элементов рельефа с прямоугольным профилем в обратно рассеянных электронах. № 1 стр. 91.

Новиков Ю.А., Раков А.В. Влияние диаметра зонда РЭМ на измерение ширины линии микро-рельефа. № 4 стр. 81.

Самойлов Л.К., Палазиенко А.А., Белякова М.Л. Выбор частоты временной дискретизации сигналов при вводе аналоговой информации в ЭВМ. № 5 стр. 104.

Терещенко С.А., Селищев С.В., Подгаецкий В.М. Определение профиля изменения ширины запрещенной зоны полупроводниковых гетероструктур по спектрам фотолюминесценции. № 2 стр. 91.

Проблемы высшего образования

Королев М.А., Ревелева М.А. Особенности подготовки магистров в области электроники. № 1 стр. 99.

Попечителев Е.П. Базовое медико-техническое образование и программы подготовки специалистов. № 2 стр. 97.

Краткие сообщения

Алексеев М.В., Тельминов А.И. Применение методов математического моделирования при выборе базового состава стеклокристаллического материала для диэлектрического покрытия МД-подложек. № 4 стр. 105.

Долгих Д.С., Сумец М.П. Исследование в сканирующем туннельном микроскопе поверхности GaAs(100), обработанной в селене. № 6 стр. 95.

Касимов Ф.Д., Рагимов М.Р. Влияние локальных областей разупорядочения на магнитосопротивление кремниевых эпитаксиальных пленок. № 6 стр. 92.

Мармалюк А.А., Акчурун Р.Х., Горбылев В.А. Расчетная оценка термодинамических функций нитридов алюминия, галлия и индия со структурой сфалерита. № 1 стр. 102.

Негоденко О.Н., Татаринцев С.А., Кошелев С.Г. Применение транзисторных аналогов негетронов в микроэлектронных радиопарных датчиках. № 6 стр. 91.

Усанов Д.А., Вениг С.Б., Скворцов С.И. Генератор автоколебаний на магнитодиоде. № 4 стр. 106.

Квантовая и физическая электроника

Карле-Шананин Р.А., Пантелеев А.В., Петровский В.Н., Проценко Е.Д., Соловьев Д.И. Динамические характеристики двухмодового YAG:Nd³⁺ лазера с полупроводниковой накачкой. № 3 стр. 30.

Пенин А.Н., Прудковский П.А. К вопросу о возможности квантовых неразрушающих изменений при трехмодовом параметрическом преобразовании. № 3 стр. 25.

Физика и технология перспективных электронных приборов

Баринов В.В. Универсальная мера для оценки быстродействия цифровых КМДП СБИС. № 3 стр. 60.

Вернер И.В., Герасименко Н.Н., Корнеев В.И. Индуцированная самоорганизация в системе примесь - дефекты в полупроводниках. № 3 стр. 65.

Горбацевич А.А., Капаев В.В., Колтыженков В.М., Цибизов А.Г. Многобарьерные резонансно-туннельные структуры. № 3 стр. 39.

Зимин С.П., Комаров Е.П. Анализ диэлектрической проницаемости пористого кремния в рамках двухфазной модели. № 3 стр. 48.

Сеченов Д.А., Светличный А.М., Агеев О.А. Распределение температуры и механических напряжений в области воздействия зонда сканирующего туннельного микроскопа в кремнии. № 3 стр. 52.

Новые методы проектирования и конструирования полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и РЭА

Абакумов А.А. (мл.). Перспективы применения матричных полупроводниковых преобразователей магнитного поля для систем слежения за развитием трещин газопроводов. № 3 стр. 90.

Казеннов Г.Г., Кремлев В.Я., Дьяконов В.М., Смирнов С.Ю. Метод потенциального базиса для физико-топологического моделирования элементов СБИС. № 3 стр. 83.

Петросяц К.О., Мальцев П.П., Рябов Н.И., Харитонов И.А., Крымко М.М. Электротепловое проектирование мощных "интеллектуальных" интегральных схем. № 3 стр. 73.

Радиотехника

Баруздин С.А., Иванов В.А. Нелинейные свойства спиновых и фотонных систем при возбуждении случайными и псевдослучайными сигналами. № 3 стр. 121.

Ипатов В.П., Хао Сяонинь. Синтез неравномерных антенных решеток на основе дискретных сигналов с хорошими корреляционно-спектральными характеристиками. № 3 стр. 103.

Кириллов С.Н., Бодров О.А., Макаров Д.А. Алгоритм синтеза системы фазоманипулированных сигналов с большой базой на основе составных последовательностей. № 3 стр. 109.

Лукьянов С.П., Семенчук В.Е. Реконструктивное подповерхностное зондирование. № 3 стр. 114.

Малютин Н.Д., Семенов Э.В., Сычев А.Н. Синтез полосковых устройств для аналоговой обработки сверхширокополосных сигналов. № 3 стр. 95.

Яковлев А.Н., Гуляев Н.В. Фазовый параметрический гидролокатор бокового обзора. № 3 стр. 127.

КНИ-структуры

Александров П.А., Баранова Е.К., Баранова И.В., Бударрагин В.В., Литвинов В.Л., Шемардов С.Г. Применение ионной имплантации водорода в КНИ-технологии. № 5 стр. 17.

Королев М.А., Шумский И.А. "Интеллектуальные" измерительные микросистемы на основе структуры кремний - на - изоляторе. № 5 стр. 34.

Крымко М.М., Енишерлова К.Л., Кошелев Н.И., Ермолаева А.И. Многослойные кремниевые структуры для силовой электроники и микроэлектроники. № 5 стр. 45.

Маковийчук М.И., Паришин Е.О., Рекишинский В.А. Физические основы технологии КНИ-структур, формируемых методом ионно-лучевого синтеза. № 5 стр. 10.

Мальцев П.П., Чапыгин Ю.А., Тимошенко С.П. Перспективы развития технологии кремний - на - изоляторе. № 5 стр. 5.

Петрова В.З., Кошелев Н.И., Ермолаева А.И., Тимошенко С.П. Технология структур кремний - на - изоляторе и многослойных кремниевых структур. № 5 стр. 30.

Попов В.П. Создание КНИ-структур для ультрабольших интегральных схем. № 5 стр. 22.

Тимошенко С.П., Прокопьев Е.П., Дягилев В.В. Движение и залечивание пор на границе сращивания пластин кремния. № 5 стр. 39.

Юбилей

В.А.Бархоткину 60 лет. № 1 стр. 104.

Е.В.Арменскому - 75 лет. № 5 стр. 110.

Л.Н. Преснухину - 80 лет. № 4 стр. 108.

Научно-производственному комплексу "Технологический центр" МИЭТ - десять лет. № 2 стр. 103.

К 50-летию транзистора

Федотов Я.А. "Бомба величиной с горошину". № 2 стр. 5.

Щука А.А. Транзисторные революции. № 2 стр. 12.

Конференции. Семинары

Информационное сообщение о 5-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции "Микроэлектроника и информатика - 98". № 2 стр. 106.

Первая Российская летняя школа молодых ученых и специалистов по материаловедению и физико-химическим основам технологий монокристаллического кремния "Кремниевая школа - 98". № 1 стр. 106.